

# 系統功能

## 曝光前

晶圓投入

Carrier stage (Sender)

去水烘烤，汽相塗佈HMDS  
改變基材表面之親疏水性

Adhesion unit

冷卻，提高製程穩定性  
旋塗阻劑前之溫度控制

Cooling plate

旋轉塗佈光阻

Spin coater unit

軟烤，去溶劑以提升附着力，  
並提升阻劑曝光與非曝光區顯  
影速率比，降低阻劑內應力

Hot plate unit

冷卻，提高製程穩定性

Interface cooling

進曝光機前之緩衝區

Interface buffer

與曝光機之間之傳送介面

Interface wafer stage

曝光

## 曝光後

與曝光機之間之傳送介面

Interface wafer stage

冷卻，提高製程穩定性

Interface cooling

曝後烤，消除駐波效應，  
進行光酸放大反應及擴散反應

Hot plate unit

冷卻，終止前一步驟之  
反應並提高製程穩定性

Cooling unit

顯影

Developer unit

硬烤，去除殘餘溶劑，  
增進附着力及薄膜品質以利  
接續之離子佈植或蝕刻製程

Hot plate unit

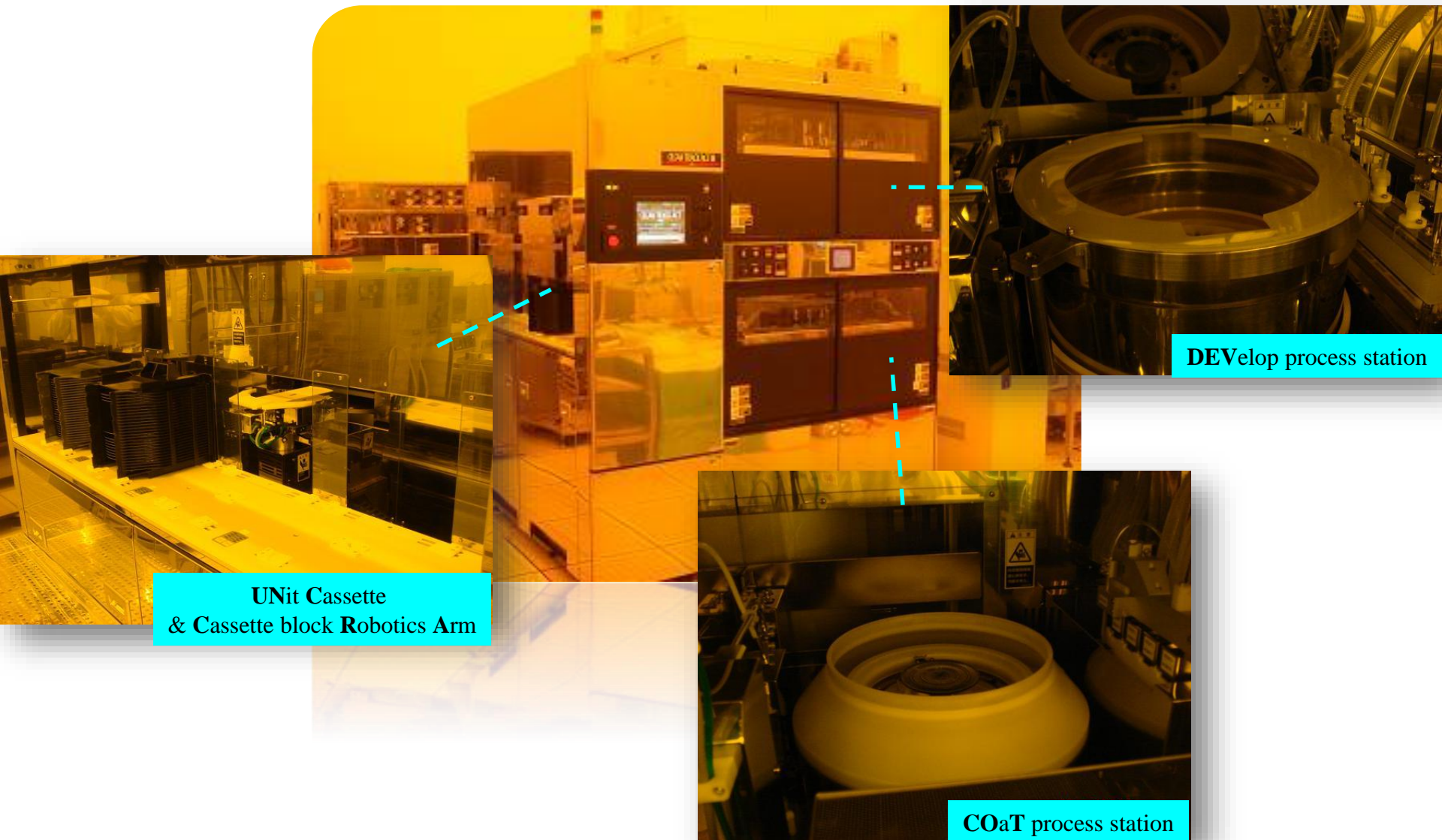
晶圓送出

Carrier stage (Receiver)

# 設備概觀



# ACT8設備主體-正面



# 服務內容

一、 僅接受標準製程委託操作。

二、 wafer限制：

僅接受8吋標準Si wafer。

1. wafer不能有缺角或裂痕。
2. wafer表面若為金屬膜或退火處理後之薄膜，目視薄膜不能有附著不良或剝離現象。
3. wafer背面，目視不能有髒污或損傷。
4. wafer經特殊製程，目視不能有變形。

三、 正常代工操作下，wafer損傷之意外風險並非為零。非人為疏失所造成之wafer代工損傷風險由委託者承擔。

四、 本規定注意事項若有未盡事宜處將適時修訂。請委託者於委託前務必再次詳閱本注意事項。

※修訂日期：2019/4/12